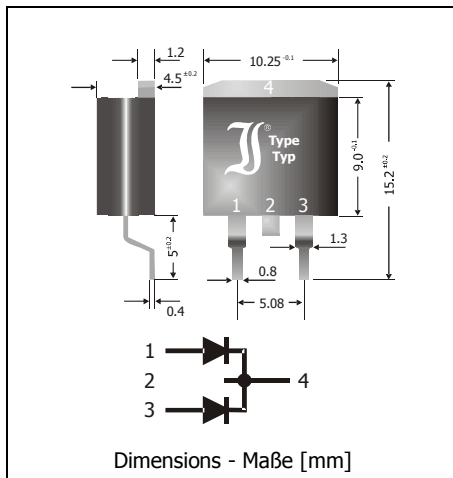


SK3020CD2 ... SK3040CD2

Surface Mount Schottky Rectifier Diodes– Common Cathode Schottky-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage – Gemeinsame Kathode

Version 2010-03-31



Nominal Current Nennstrom	30 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...40 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	TO-263 D2PAK
Weight approx. Gewicht ca.	1.6 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging in tubes Standard Lieferform in Stangen	



Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	Forward Voltage Durchlass-Spannung V_F [V] ^{1) 2)}	
			$I_F = 5 A$	$I_F = 15 A$
SK3020CD2	20	20	< 0.49	< 0.55
SK3030CD2	30	30	< 0.49	< 0.55
SK3040CD2	40	40	< 0.49	< 0.55

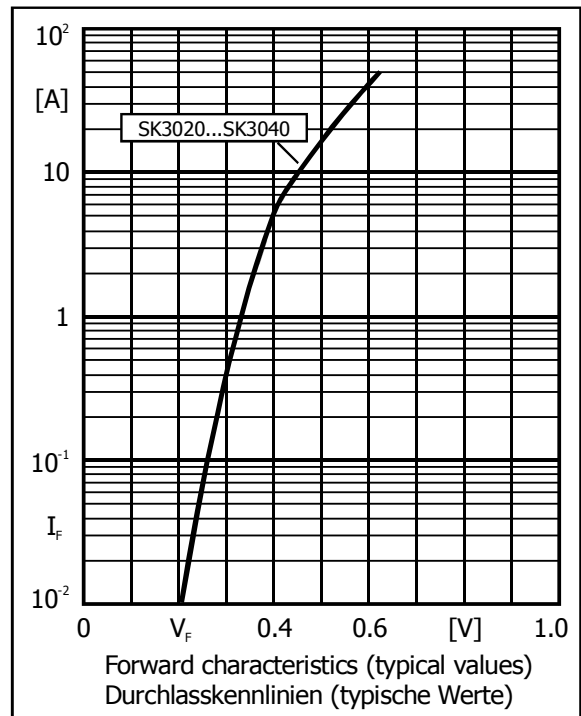
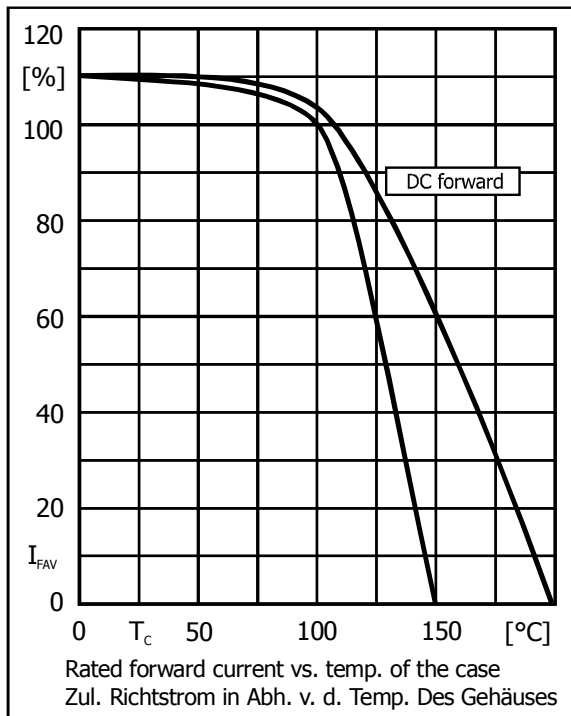
Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^\circ C$	I_{FAV} I_{FAV}	15 A ¹⁾ 30 A ²⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 Hz$	I_{FRM}	55 A ²⁾
Peak forward surge current 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ C$	I_{FSM}	280/320 A ²⁾
Rating for fusing, $t < 10 ms$ Grenzlastintegral, $t < 10 ms$	$T_A = 25^\circ C$	i^2t	390 A ² s ²⁾
Junction temperature – Sperrschichttemperatur in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb		T_j T_j	-50...+150°C ≤ 200°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	-50...+175°C

1 $T_j = 25^\circ C$
1 Per diode – Pro Diode

Characteristics

Kennwerte

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	I_R	< 500 μA < 45 mA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht - Gehäuse		R_{thc}	< 1.5 K/W^{-1})



2 Per device (parallel operation) – Pro Bauteil (Parallelbetrieb)
1 Per device (parallel operation) – Pro Bauteil (Parallelbetrieb)